# **Electronic transport properties of doped graphene-like** borophene by ab initio calculations

Mansoureh Pashangpour<sup>1,\*</sup>, Somayeh Fotoohi<sup>2</sup>

Department of Physics, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran<sup>1</sup>

Department of Electrical Engineering, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran<sup>2</sup>

Received: 14.07.2019 Final revised: 17.03.2021 Accepted: 26.04.2021

DOI: 10.22055/JRMBS.2021.16784

#### Abstract

In this paper, the electronic transport properties of graphene-like borophene as well as its doped structures with boron, carbon and nitrogen atoms are investigated using the density functional theory. Total and partial density of states, band structure, charge density, quantum conductance and current-voltage characteristic of these structures have been studied and compared. The results indicate that graphene-like borophene is a metal, and has a Dirac point with a linear dispersion relation similar graphene. Our investigations demonstrate that the Dirac point is in upper place than the Fermi level, and the doping can affect the location of Dirac point. Moreover, the currentvoltage characteristics show Ohmic behavior of these structures. In doped graphene-like borophene structures, boron atoms are formed ionic bonds. In all considered structures, the current density along zigzag and armchair directions exhibit an anisotropic behavior. By 90° rotation of graphene-like borophene sheet with carbon atom, its current is controlled and this material can be used to design nanoelectronic switches. The current control with C atom doping can be used in this two-dimensional material to design nanoelectronic switches.

**Keywords:** Graphene-like Borophene, Density functional theory, Density of states, Quantum transport

\*Corresponding Author: poor@iiau.ac.ir



# مطالعه تأثیر آلایش بر خواص ترابرد الکترونی بوروفین گرافین گونه با محاسبات ابتدا بهساکن

**منصوره پشنگ پور<sup>1, \*</sup>، سمیه فتوحی<sup>2</sup>** <sup>1</sup>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

<sup>2</sup>گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران دریافت:1398/04/23 ویرایش نهایی: 1399/12/27 پذیرش: 1400/02/06

DOI: <u>10.22055/JRMBS.2021.16784</u>

## چکیدہ

در این مقاله، بوروفین گرافین گونه که اخیراً ساخت تجربی آن روی زیر لایه (Al(111) گزارش شده است و سه ساختار آلاییده آن با بور، کربن و نیتروژن از طریق نظریه تابعی چگالی مطالعه شده است. چگالی حالات کلی و جزئی، ساختار نوارهای انرژی، چگالی بار، رسانش کو آنتمی و نمودارهای جریان -ولتاژ این ساختارها بررسی و مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که بوروفین گرافین گونه فلز است و همانند گرافین، نقطه دیراکی با رابطهٔ پاشندگی خطی داشته که در مکانی بالاتر از تراز فرمی قرار دارد و آلایش آن با اتم های بور، کربن و نیتروژن باعث جابه جایی مکان نقطهٔ دیراک می گردد. اتم های بور در بوروفین آلایش شده درگیر پیوندهای یونی می شوند. همچنین نتایج نشان می دهد که نمودارهای جریان -ولتاژ ساختارهای مورد مطالعه رفتار اهمی دارند. چگالی جریان ناهمسانگرد در دو راستای زیگزاگ و آرمچیر با قابلیت کنترل جریان توسط آلایش، استفاده از این ماده دو بعدی را در طراحی سویچهای نانو الکترونیک ممکن می سازد.

که در سال 2015 به طور تجربی در شرایط خلاً کامل

روی زیر لایه (Ag (111) رشد داده شده است [6].

ساختارهای دو بعدی مختلفی از بوروفین در شکل های

مثلثی چروکیده و همچنین با حفرههای ششگوشی

مشاهده شده است [7]. مشابه دیگر مواد دو بعدی،

بوروفين نيز خواص الكترونيكي، مكانيكي، ابرسانايي و

رسانش گرمایی جالب توجهای از خود نشان میدهد که

از آن جمله می توان به خاصیت فلزی و مکانیکی با

ناهمسانگردی بالا، رسانش گرمایی و دمای ابرسانایی

پايين اشاره نمود [12-8]. مطالعات روى خواص

مکانیکی بوروفین نشان میدهد که این ساختار در یک

كليدواژگان: بوروفين گرافين گونه، نظريه تابعي چگالي، چگالي حالات، انتقال الكتروني

#### مقدمه

ساختارهای دو بعدی در دهه گذشته مورد توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران قرار گرفتهاند. گرافین شبهفلزی با فرمیونهای بدون جرم، یکی از این مواد دو بعدی است که قابلیت رسانش الکتریکی بسیار خوبی دارد و گزینه مناسبی برای کاربرد در قطعات نانوالکترونیکی است. پس از گرافین [1] به تدریج مواد دو بعدی عنصری دیگری مانند فسفرین [2]، ژرمانین [3]، سیلیسین [4]، استانین [5]، بوروفین [6] و ... سنتز و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. در این میان بوروفین، تک لایهای از اتمهای بور، ساختار دو بعدی جدیدی است

(i) (ii)

باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است. بن مقاله تحت مجوز کرینیو کامنز تخصیص 4.0 بین المللی می باشد

2

<sup>\*</sup> نویسنده مسئول: poor@iiau.ac.ir

راستا سخت و در راستای دیگر شکننده است [12و9]. با توجه بهخواص جالب بوروفين، اين ماده قابليت استفاده در ادوات نانوالکترونیک خواهد داشت. ساختار دیگری از بوروفین که بهشکل لانه زنبوری (بوروفین گرافینگونه) است در سال 2018 روی زیر لایه Al(111) در آزمایشگاه سنتز شد [13]. این شکل از بوروفین، به دلیل الکترون پذیری بالای بور بدون زیرلایه نايايدار است. آلايش بوروفين گرافينگونه مانند ساختارهای دو بعدی دیگر میتواند بر خواص فیزیکی و شیمیایی بوروفین تأثیر گذاشته و باعث پایداری آن شود. نتایج پژوهش شاهرخی در سال 2019 نشان مىدهد كه ساختار بوروفين گرافينگونه با آلايش فلوئور و کلر پایدار است [14]. در پژوهشهای دیگر نیز پایداری و خواص ترابرد الکترونی بوروفین گرافین گونه با اَلایش اکسیژن [15]، هیدروژن و فلوئور [16] بررسی شده است. از آنجائیکه اتمهای کربن و نیتروژن در جدول مندلیف در همسایگی اتم بور قرار دارند، گزینه های مناسبی برای افزودن به این ماده دو بعدی

بنابراین در این پژوهش ساختار الکترونی و خواص انتقال الکترونی بوروفین گرافینگونه بدون و با آلایش بور، کربن و نیتروژن با استفاده از نظریهٔ تابعی چگالی بررسی و مقایسه خواهد شد. همچنین تأثیر آلایش بر عملکرد و تغییر میزان ناهمسانگردی در انتقال الکترونی نشان میدهد که چگالی جریان در دو راستای زیگزاگ و آرمچیر برای ساختارهای مورد مطالعه، ناهمسانگرد است. همچنین نوع آلایش، روی مقدار چگالی جریان در این دو راستا و میزان ناهمسانگردی آن تأثیر گذار میباشد. از این قابلیت میتوان در طراحی سویچهای نانوالکترونیک استفاده نمود.

مراحل محاسبات ساختار الكتروني محاسبات ساختار الكتروني بر اساس نظرية تابعي چگالی با تقریب گرادیان تعمیمیافته توسط کد محاسباتي كوأنتوم اسپرسو [17] و محاسبات مربوط به رسانش کو آنتومی توسط کد WanT [18] انجام شده است. سلول واحد، ارتورومبیک (راست لوزی ساده) و شامل چهار اتم بور در نظر گرفته شده است (شكل1الف). ثابتهاى شبكه a=5/079Å، و b = 2/93Å و b = 2/93 بهدست آمدهاند که با نتایج تحقيق قبلي مطابقت دارد [19]. خلأ بين صفحات بوروفین در جهت محور z به منظور حذف برهمکنش لایههای موازی بوروفین 20Å در نظر گرفته شده است. انرژی قطع 50Ryd و سلولبندی ناحیهٔ اول بریلئون 1×20×16 انتخاب شدهاند [20]. واهلش كامل شبكه و مكان اتمها تا نيروى <u>وeV</u> انجام شدهاست. فاصله اتمهای بور با نزدیکترین همسایه خود 1/693Å بەدست آمدەاست.



الف



**شکل1.** الف: دید از بالای بوروفین گرافینگونه خالص و سلول واحد آن. ب: دید از بالای بوروفین گرافینگونه آلایش شده که X نشانگر اتم بور، کربن یا نیتروژن در ساختار آلاییده است.

حفرههای شش گوشی در ساختار بوروفین گرافین گونه (شکل الف1) فضای مناسبی برای آلایش آن با اتمهای کوچک است. در این پژوهش، هدف بررسی ویژگی های الکترونیکی و انتقالی ساختار بوروفین گرافین گونه خالص و آلاییده با اتمهای کربن، بور و نیتروژن (شکل 1ب) است. در شبیه سازی ها، سلول واحد ارتورومبیک شامل چهار اتم بور برای بوروفین گرافین گونه و یک اتم بور (کربن و یا نیتروژن) به عنوان آلایش در نظر گرفته شده است.

## نتایج ساختار الکترونی بوروفین گرافینگونه خالص و با آلایش

شکل2 چگالی حالات کل بوروفین گرافینگونه خالص و همچنین دارای آلایش کربن، بور و نیتروژن را نشان میدهد. همچنین در این شکل چگالی حالات جزئی برای اوربیتالهای py .px و pz نشان داده شده است.

شکل 3 ساختار نوارهای انرژی بوروفین گرافین گونه خالص و با آلایش را نشان می دهد. با توجه به ساختار نوارهای انرژی بوروفین گرافین گونه، نقطهٔ دیراک بهاندازهٔ 3/44eV بالاتر از تراز فرمی و در مسیر تقارنی بهاندازهٔ ۲–۲ تشکیل شده است. نمودار PDOS متناظر با آن نشان می دهد که مخروط دیراک توسط اوربیتال های pz (بین  $\pi$  و  $\pi$ ) ایجاد شده است (شکل الف3). همان طوری که در شکل الف-2 مشاهده می شود تراز فرمی اوربیتال های  $\sigma$  را قطع می کند.

مطابق شکل2، برای ساختارهای بوروفین گرافینگونه با آلایش بور، کربن و نیتروژن نقطه دیراک، بهترتیب در انرژی 0/32 eV،1/84 eV و 1/2 eV بالاتر از تراز فرمی نیز مشاهده میشود و نکته قابل توجه آن است که نقطه دیراک در ساختارهای با آلایش نسبت به نقطهٔ دیراک

4

بوروفین گرافین گونه خالص در فاصلهٔ کمتری نسبت به تراز فرمی قرار دارد.

مطابق شکل نمودار چگالی حالات جزیی بوروفین گرافینگونه با آلایش بور (شکل2ب) درمی یابیم که نقطهٔ دیراک توسط اوربیتالهای pz (بین  $\pi$  و  $\pi$ ) تشکیل شده است. نقطهٔ دیراک وسط گاف میان  $\sigma$  و  $\sigma$  قرار گرفته است. همچنین تراز فرمی بر لبه اوربیتال  $\sigma$ منطبق است (شکل2ب). مطابق شکل نمودار چگالی حالات جزئی بوروفین گرافینگونه با آلایش بور (شکل2پ)، اوربیتال  $\sigma$  پایین تر از تراز فرمی قرار گرفته و تراز فرمی به اوربیتال  $\pi$  نزدیک شده است.





**شکل2** نمودار چگالی حالات جزئی بوروفین گرافینگونه الف: خالص ب: آلایش شده با بور، پ: آلایش شده با کربن و ت: آلایش شده با نیتروژن. انرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.

سهم عمده چگالی حالات الکترونی بوروفین گرافین گونه با آلایش بور، کربن و نیتروژن در نزدیک تراز فرمی، مربوط به اوربیتالهای pz است در حالی که برای بوروفين گرافين گونه بدون آلايش، هر سه اوربيتال px، py وpz در اطراف تراز فرمی توزیع شدهاند. درصد سهم هر یک از اوربیتالهای py ،px و zz در چگالی حالات الکترونی در تراز فرمی برای اتم B بوروفین گرافین گونه بدون آلايش بهترتيب %7/1 ، %7/1 و 9/7% مى باشد (جدول1). درصد سهم اور بيتال pz براى اتم B شمارة 1 (2، 3 و4) در ساختار آلائيده با بور، %1 است. این سهم برای ساختار آلائیده با کربن برای اتم B شمارة 1(2) و 3(4) بهترتيب 23/2% و 15/4% و براى ساختار آلائیده با نیتروژن برای اتم B شمارهٔ 1(2) و 3(4) بەترتىب %15/8 و %9/6 مىباشد. ھمچنىن درصد سھم اوربیتال pz اتم بور، کربن و نیتروژن در ساختار آلائیده بەترتىب 3/8%، 10/2% و 9/6% است. سەم اورېيتال ھاي py ،px در ساختارهای آلائیده مطالعه شده در مقایسه با سهم اوربيتال pz ناچيز است.

**جدول1**. درصد سهم اوربیتالهای pz در چگالی حالات الکترونی در تراز

			فرمى
ساختار	B1(B2)	B3(B4)	آلايش
بوروفين گرافينگونه	9,7%	9,7%	-
بوروفين گرافينگونه با	17%	17%	3,8%
آلايش بور			
بوروفين گرافينگونه با	23 <sub>/</sub> 2%	15 <sub>/</sub> 4%	10,2%
آلايش كربن			
بوروفين گرافينگونه با	15 <sub>/</sub> 8%	9,6%	9,6%
آلايش نيتروژن			



**شکل3.** ساختار نواری بوروفین گرافین گونه الف: خالص .ب: آلایش شده با بور، پ: آلایش شده با کربن و پ: آلایش شده با نیتروژن. انرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.

با توجه به ساختار نواری بوروفین گرافینگونه، نوار انرژی در دو طرف نقطه *S*، مسطح شده است که باعث ایجاد دو پیک وان-هوف را در نمودار PDOS در طرفین انرژی فرمی شده است. ساختار نواری و چگالی

حالات بهدست آمده برای بوروفین گرافین گونه با آلایش بور، توافق خوبی با نتایج پژوهش علیزاده واجاری و همکارانش دارد [21].

ساختار بوروفین گرافینگونه، نسبت به اتمهای ناخالصی بور و کربن، الکترون گیرنده و نسبت به اتم ناخالصی نیتروژن، الکترون دهنده است. مقدار بار <sup>-</sup> 0/021 و واحد بوروفین گرافینگونه منتقل می شود در حالی که با آلایش نیتروژن، بار <sup>-</sup> 12/04 از سلول واحد بوروفین گرافین گونه بهاتم نیتروژن انتقال می یابد. انرژی فرمی بوروفین گرافین گونه بدون آلایش V9 25/05- است که با آلایش بور، کربن و نیتروژن به ترتیب به می کند.

انرژی جذب  $E_{al} = E_{Total} - (E_{g-borophene} + E_{center-atom})$  برای بوروفین گرافین گونه با آلایش بور، کربن و نیتروژن بهترتیب 8/39 eV - 16/51 eV و 4/51 eV - بهدست آمده است که مقدار بالای انرژی جذب، نشانگر پایداری ساختارهای آلاییده میباشد.



شکل4. چگالی بار الف: بوروفین گرافینگونه خالص ب: آلایش شده با بور، پ: آلایش شده با کربن و پ: آلایش شده با نیتروژن در صفحه (001).

نواحی قرمز رنگ، بیشترین چگالی بار و نواحی آبی رنگ، کمترین چگالی بار را مشخص میکنند

شکل 4، چگالی بار در صفحهٔ (001) و شکل 5 چگالی بار در صفحهٔ (010) را برای ساختارهای بوروفین گرافین خالص و آلایش شده با اتمهای بور، کربن و نیتروژن را نشان میدهند. همان طور که مشاهده می شود توزیع بار برای بوروفین گرافین گونه خالص در طول پیوندهای B-B به شکل متقارن است در صورتی که با آلایش، توزیع بار پیوندهای B-B در اطراف محل آلایش نامتقارن شده است. چگالی بار بر اساس چگالی بار لایه ظرفیت، با استفاده از روش لودین محاسبه شده است.



شکل5. چگالی بار بوروفین گرافینگونه در صفحهٔ (010) الف: خالص ب: آلایش شده با بور، پ: آلایش شده با کربن و پ: آلایش شده با نیتروژن. نواحی قرمز رنگ، بیشترین چگالی بار و نواحی آبی رنگ، کمترین چگالی بار را مشخص میکنند.

روش محاسبات رسانش کوانتومی محاسبات مربوط به رسانش کوآنتمی توسط کد WanT انجام شده است. در این کد رسانش کل سیستم بر اساس فرمولبندی لاندائور با توجه به تابع عبور، T(E<sub>f</sub>)، قابل محاسبه است [22]:

$$C = \frac{2e^2}{h}T(E_f) = \frac{2e^2}{h}Tr(\Gamma_L G_C^r \Gamma_R G_C^a)$$



شکل6. رسانش کوآنتمی بوروفین گرافین گونه (الف) خالص (ب) آلایش شده با بور، (پ) آلایش شده با کربن و (پ) آلایش شده با نیتروژن. انرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است. uw (unit cell width) طول سلول واحد در راستای عمود بر انتقال است.

در هر چهار ساختار مورد مطالعه، مقدار رسانش در نقطهٔ دیراک کمینه موضعی دارد. نکتهٔ قابل توجه آنکه رفتار رسانش بوروفین گرافین گونه خالص و دارای آلایش در دو جهت x و y متفاوت است که نشاگر ناهمسانگری خواص انتقالی این ساختارها است. رسانش بوروفین گرافین گونه با آلایش کربن اطراف تراز فرمی در جهت y تقریباً دو برابر رسانش در جهت x است. نتایج بهدست آمده برای رسانش بوروفین گرافین گونه با آلایش بور با نتایج پژوهش شوکلا [23]، توافق خوبی دارد.

نمودارهای جریان-ولتاژ (شکل7) نیز نتایج مشاهده شده در رسانش این ساختارها را تأیید میکنند. رفتار اهمی در نمودارهای جریان-ولتاژ این ساختارها مشاهده می شود. آلایش-چگالی جریان در هر دو جهت x و y را كاهش مىدهد. با توجه بەشكل7، ألايش با بور (کربن) بیشترین تغییرات را در  $(I_x)$  نسبت به ساختار خالص ایجاد کرده است. کمترین تغییرات در چگالی های جریان برای بوروفین گرافین گونه با آلایش نيتروژن مشاهده مي شود. در محدودهٔ ولتاژ باياس 0 تا 1 ولت، نسبت چگالی جریان در جهتx به چگالی جریان در جهتy (I, /I) برای بوروفین گرافین گونه با شيب بسيار كم از 1/18 به 1/19 افزايش مى يابد. اين نسبت در بوروفین گرافین گونه با آلایش بور از 0/9 به1/03 افزایش و برای آلایش با نیتروژن از 1/06 به 1/01 کاهش دارد و برای بوروفین گرافین گونه با آلایش کربن از 0/52 به 0/55 افزایش مییابد. میزان ناهمسانگردی در چگالی جریان و رسانش کوآنتمی در بوروفین گرافینگونه با آلایش کربن از دو آلایش دیگر بیشتر است. این ناهمسانگردی در چگالی جریان برای بوروفين گرافين گونه با آلايش بور و نيتروژن تقريباً ناچيز است. چگالی جریان بهدست آمده برای بوروفین گرافین گونه با آلایش بور با نتایج پژوهش شوکلا [23]، توافق خوبي دارد.



**شکل7.** نمودار چگالی جریان در راستای الف: x و ب: y برحسب ولتاژ بایاس برای بوروفین گرافینگونه خالص، آلایش شده با بور، کربن و نیتروژن.

ناهمسانگردی در <sub>x</sub> I و <sub>y</sub> بوروفین گرافینگونه و بوروفین گرافینگونه با آلایش کربن دیده میشود ولی نوع ناهمسانگردی این دو ساختار با یکدیگر متفاوت است.



**شکل8** نمودار نسبت چگالی جریان در راستای x به y برحسب ولتاژ بایاس برای بوروفین گرافینگونه خالص، آلایش شده با بور، کربن و نیټروژن.

در شکل8، نسبت  $_v I_x / I_x$  در محدوده ولتاژ بایاس 1-0 ولت نشان داده شده است. این نسبت می تواند معیار سنجش میزان ناهمسانگردی در دو جهت x و y باشد. مقدار این نسبت هر چقدر از یک فاصلهٔ بیشتری داشته باشد میزان ناهمسانگردی نیز بیشتر خواهد بود. نسبت  $_v I_x / _x$ برای بوروفین گرافینگونه خالص و با آلایش کربن در محدود ولتاژ مورد مطالعه، مقدار تقریباً ثابتی به ترتیب 1/2 و 5/0 است. این دو ساختار و رسانش کوآنتومی در بوروفین گرافینگونه با آلایش کربن از دو ساختار آلاییده دیگر بیشتر می باشد. ناهمسانگردی در چگالی جریان برای بوروفین گرافینگونه با آلایش بور و نیتروژن تقریباً نامحسوس است. نمودارهای جریان -ولتاژ رفتار اهمی این ساختارها را نشان می دهد. نسبت  $_{x}I / _{x}I$  در ولتاژ بایاس آولت برای بوروفین گرافینگونه 1/19، بوروفین گرافینگونه با الایش بور، کربن و نیتروژن بهترتیب 1/03، 55،00 ا/01 است. آلایش باعث کاهش چگالی جریان در هر دو مهت x و y شده است. آلایش با بور بیشترین تغییرات را در  $_{x}I$  و آلایش با کربن بیشترین تغییرات را در  $_{x}I$ ایجاد کرده است. با توجه بهنتایج بهدست آمده از تأثیر آلایش بر ناهمسانگردی در انتقال الکترونی بوروفین گرافینگونه، این ماده قابلیت استفاده در سویچ نانوالکترونیکی را خواهد داشت.

مرجعها

[1] K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov,
D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V.
Grigorieva, A.A. Firsov, Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films. *Science* 306 (2004) 666-669.
10.1126/science.1102896

J. Zheng, Z. [2] Χ. Hu, Ren, coupling Strong interlayer in phosphorene/graphene der Waals van heterostructure: A first-principles investigation, Frontiers in Physics 13 (2017) 137302. https://doi.org/10.1007/s11467-017-0736-0

[3] G. Liu, S. Liu, B. Xu, C. Ouyang, H. Song, S. Guan, and S. Yang, Multiple Dirac Points and Hydrogenation-Induced Magnetism of Germanene Layer on Al (111) Surface, *Journal of Physical Chemistry Letters* **6** (2015). https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b02413

[4] G. Liu, X. Lei, M. Wu, B. Xu, C. Ouyang, Comparison of the stability of free-standing silicene and hydrogenated silicene in oxygen: a first principles investigation, *Journal of Physics: Condensed Matter* **26** (2014) 355007. DOI:10.1088/0953-8984/26/35/355007 ناهمسانگردی بالایی در انتقال الکترونی نسبت به دو ساختار دیگر از خود نشان میدهند. بوروفین گرافینگونه با آلایش بور و نیتروژن، در محدودهٔ ولتاژ ما-0.10 ولت تقریباً ناهسانگرد نیستند ولی در ولتاژهای پایین تر ناهمسانگردی ضعیفی از خود نشان میدهند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که چگالی جریان در دو راستای زیگزاگ و آرمچیر برای ساختارهای مورد مطالعه، ناهمسانگرد است. همچنین نوع آلایش، روی مقدار چگالی جریان در این دو راستا و میزان ناهمسانگردی آن تأثیر گذار میباشد. از این قابلیت میتوان در طراحی سویچهای نانوالکترونیک استفاده نمود. با مقایسه میزان ناهمسانگردی ساختارهای مورد مطالعه، بوروفین گرافینگونه خالص و با آلایش کربن، برای استفاده در سویچهای نانوالکترونیکی مناسب

### بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق با استفاده از محاسبات ابتدا بهساکن، ساختار الكتروني و انتقالي بوروفين گرافين گونه بدون و با آلایش بور و کربن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبات نشان میدهد که نقطهٔ دیراک بوروفین گرافین گونه، بالای انرژی فرمی قرار دارد و آلایش سبب می شود تا مکان نقطه دیراک به سمت انرژی فرمی جابهجا شود. همچنین، چگالی بار پیوندهای بور-بور در بوروفين گرافين گونه متقارن است ولي آلايش توازن بار را بههم میزند و پیوند کووالانسی تا حدودی یونی مي شود. لايهٔ بور در ساختار بوروفين گرافين گونه آلاييده با بور و کربن، الکترونگیرنده و در ساختار آلاییده با نيتروژن الكتروندهنده است. مقادير انرژي جذب نشان میدهد که بوروفین گرافین گونه با آلایش بور یایداتر از آلایش با کربن و نیتروژن است. رسانش بوروفین گرافین گونه دارای آلایش کربن در جهات x وy ناهمسانگرد است و این ناهمسانگردی در چگالی جریان

10

[15] H. Yuan, C. Na, C. Chao, X. ShiYun & Z. JianWei, Tuning the electronic transport anisotropy in borophene via oxidation strategy, *SCIENCE CHINA Technological Sciences* 62 (2019) 799-810. <u>https://doi.org/10.1007/s11431-018-9385-x</u>

[16] M. Pashangpour, Electronic transport properties of partially hydrogenated and fluorinated borophene, a DFT study, *Computational Materials Science* **168** (2019) 74-80. DOI: 10.1016/j.commatsci.2019.05.052

[17] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G. L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, et al., *Journal of Physics: Condensed Matter* **21** (2009) 395502.

[18] A. Ferretti, B. Bonferroni, A. Calzolari, M. Buongiorno Nardelli, http://www.wannier-transport.org.

[19] C. Lee, B. Feng, M. D'angelo, R. Yukawa, R. Liu, T. Kondo, H. Kumigashira, I. Matsuda, and T. Ozaki, Peculiar bonding associated with atomic doping and hidden honeycombs in borophene, *Physical Review B* **97** (2018) 075430. DOI: 10.1103/PhysRevB.97.075430

[20] H. Monkhorst, J. Pack: Special points for Brillouin-zone integrations. *Physical Review B* 13 (1976) 5188. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.13.5188

[21] R. Alizadeh Vajary, S. Izadi Vishkayi, M. Bagheri Tagani, Study of the Influence of Structural Defects on Mechanical and Electrical Properties of  $\beta_{12}$  Borophene, *Journal of Research on Many-body Systems* **9** 3 (2019) 40-48. doi:10.22055/jrmbs.2019.14904

[22] S. Datta, *Electronic Transport in Mesoscopic Systems*, Cambridge university press, (1997).

[23] V. Shukla, A. Grigoriev, N. Jena, R. Ahuja, Strain controlled electronic and transport anisotropies in two-dimensional borophene sheets, *Physical Chemistry Chemical Physics*.20 (2018) 22952. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.13.5188 [5] J. Yuhara, Y. Fujii, K. Nishino, N. Isobe, M. Nakatake, L. Xian, A. Rubio, G. Lay, "Large area planar stanene epitaxially grown on Ag(1 1 1)". *2D Materials. 5 2* (2018) 025002.

[6] A.J. Mannix, et al. Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs. *Science* **350** (2015) 1513. <u>DOI:</u> <u>10.1126/science.aad1080</u>

[7] L. Kong, K. Wu, L. Chen, Recent progress on borophene: Growth and structures, *Frontiers in Physics* **13 3** (2018) 138105. https://doi.org/10.1007/s11467-018-0752-8

[8] Z. Wang, T. Lü, H. Wang, et al., *Frontiers in Physics* **14** (2019) 33403. https://doi.org/10.1007/s11467-019-0884-5

[9] V. Wang, W. Geng, Lattice defects and the mechanical anisotropy of borophene, *Journal of Physical Chemistry C* **121** *18* (2017) 10224. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b02582

[10] H. Xiao, W. Cao, T. Ouyang, S. Guo, C. He & J. Zhong, Lattice thermal conductivity of borophene from first principle calculation, *Scientific Reports volume* **7** (2017) 45986. https://doi.org/10.1038/srep45986

[11] E.S. Penev, A. Kutana, B.I. Yakobson, Can two dimensional boron superconduct? *Nano Letters* **16** 4 (2016) 2522-2526. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b00070

[12] H. Wang, Q. Li, Y. Gao, F. Miao, X. Zhou, X. Wan, Strain effects on borophene: Ideal strength, negative Possion's ratio and phonon instability, *New Journal of Physics* **18** 7 (2016) 073016.

[13] W. Li, L. Kong, C. Chen, J. Gou, S. Sheng, W. Zhang, H. Li, L. Chen, P. Cheng, K. Wu, Experimental realization of honeycomb borophene, *Science Bulletin* **63** (2018) 282-286.

[14] M. Shahrokhi, Can fluorine, chlorine functionalization stabilize the graphene like borophene?, *Computational Materials Science 156* (2019) 56-66. DOI:10.1016/j.commatsci.2018.09.045